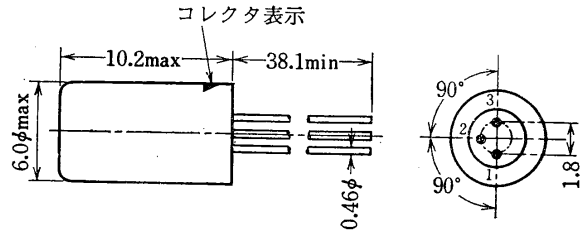


2SB75, 2SB75A

2SB76

(保守用)

ゲルマニウム PNP 合金接合形
低周波小信号増幅用



1. エミッタ 2. ベース 3. コレクタ

■ 最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)		2SB75	2SB75A	2SB76
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-25	-45	-18 V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	-25	-45	-18 V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-12	-12	-2.5 V
コレクタ電流	I_C	-100	-100	-100 mA
エミッタ電流	I_E	100	100	100 mA
許容コレクタ損失	P_C	150	150	150mW
接合部温度	T_j	85	85	85 °C
保存温度	T_{stg}	-55~+85	-55~+85	-55~+85 °C

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)		2SB75			2SB75A			2SB76		
		最小	標準	最大	最小	標準	最大	最小	標準	最大
コレクタ遮断電流	I_{CBX} ($V_{CB}=-25\text{V}, V_{EB}=-6\text{V}$)...	—	—	-14	—	—	—	—	—	—
コレクタ遮断電流	I_{CBX} ($V_{CB}=-45\text{V}, V_{EB}=-6\text{V}$)...	—	—	—	—	—	-25	—	—	—
コレクタ遮断電流	I_{CBX} ($V_{CB}=-12\text{V}, V_{EB}=-6\text{V}$)...	—	—	—	—	—	—	—	—	-14
エミッタ遮断電流	I_{EBO} ($V_{EB}=-12\text{V}, I_C=0$)	—	—	-12	—	—	-12	—	—	—
小信号入力インピーダンス	h_{ie} ($V_{CE}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}$) $(f=270\text{c/s})$	—	1750	—	—	1750	—	—	1750	—
小信号電圧帰還率	h_{re} (")	—	3.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—
小信号電流増幅率*	h_{fe} (")	—	55	—	—	55	—	—	55	—
小信号出力アドミタンス	h_{oe} (")	—	17.5	—	—	17.5	—	—	17.5	—
雑音指数	NF ($V_{CE}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}$) $(f=1\text{kc})$	—	7	—	—	7	—	—	7	—

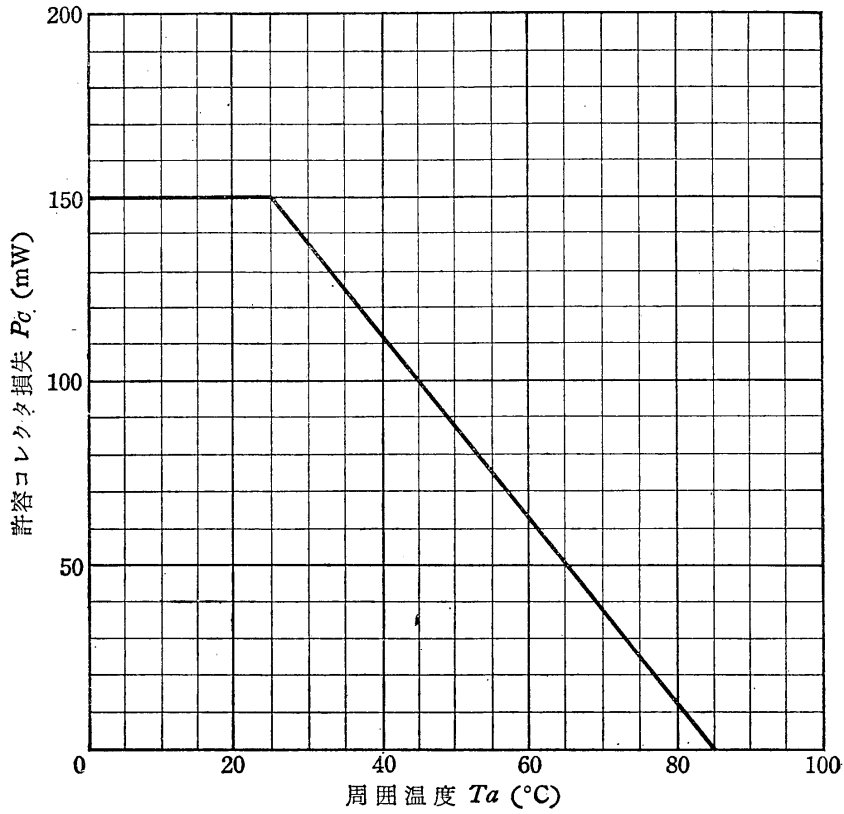
遮断周波数	$f_{\alpha b}$ ($V_{CB}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}$)	—	2.0	—	—	2.0	—	—	2.0	—
-------	--	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---

* 2SB75, 75A は h_{fe} の値により下記のように3区分し現品にそれぞれⒶ, Ⓑ, Ⓒと表示してあります。

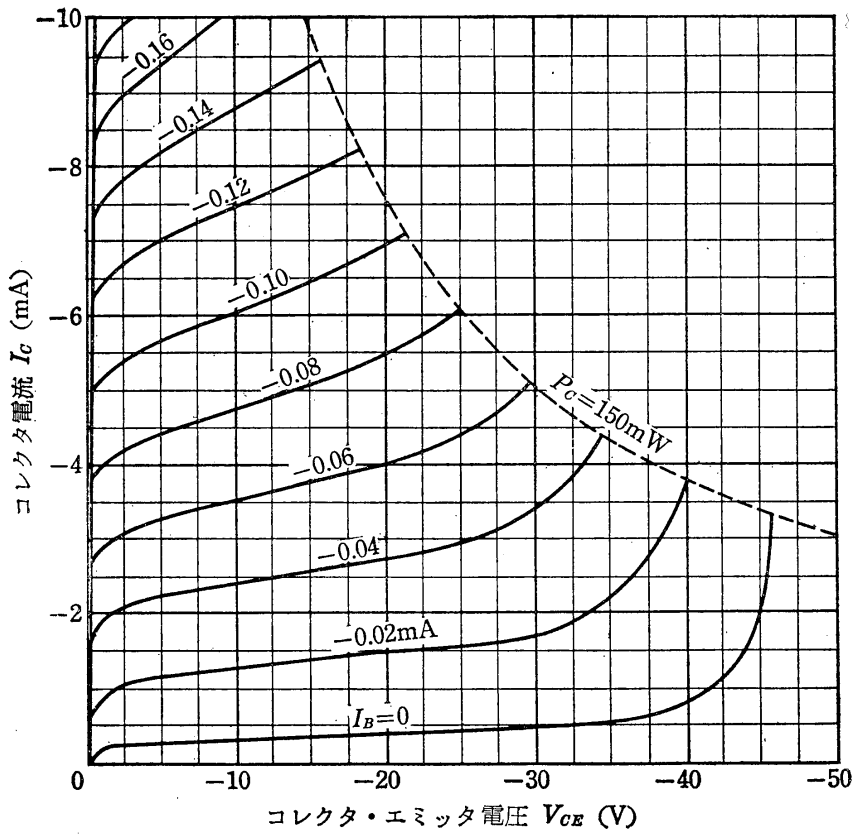
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
h_{fe}	40	55	70

2SB75, 2SB75A, 2SB76

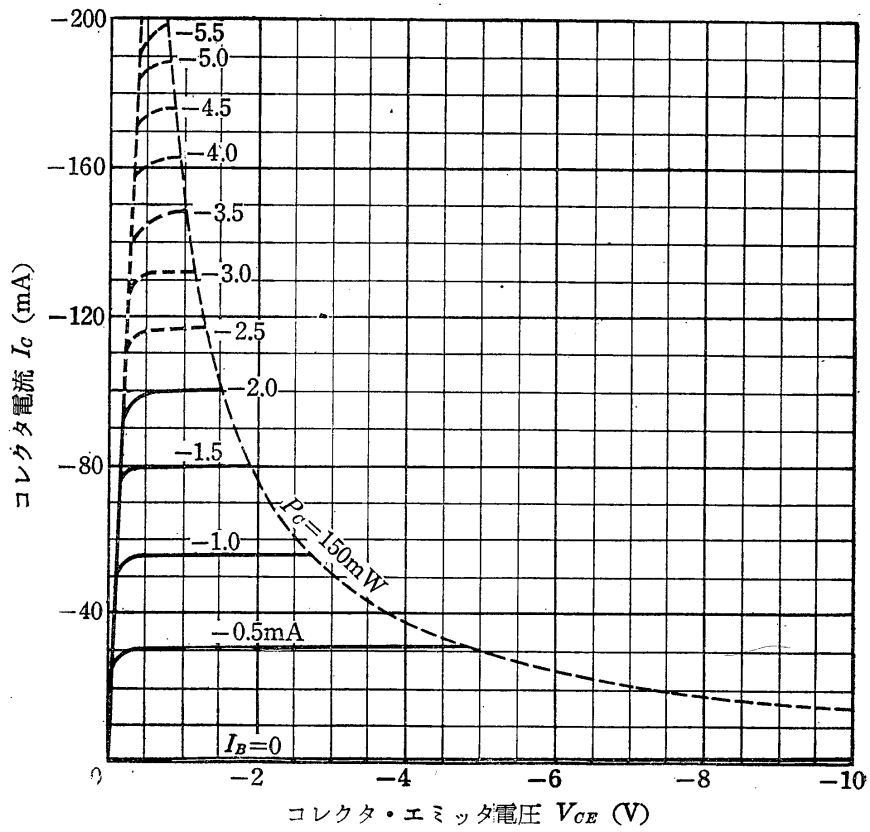
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



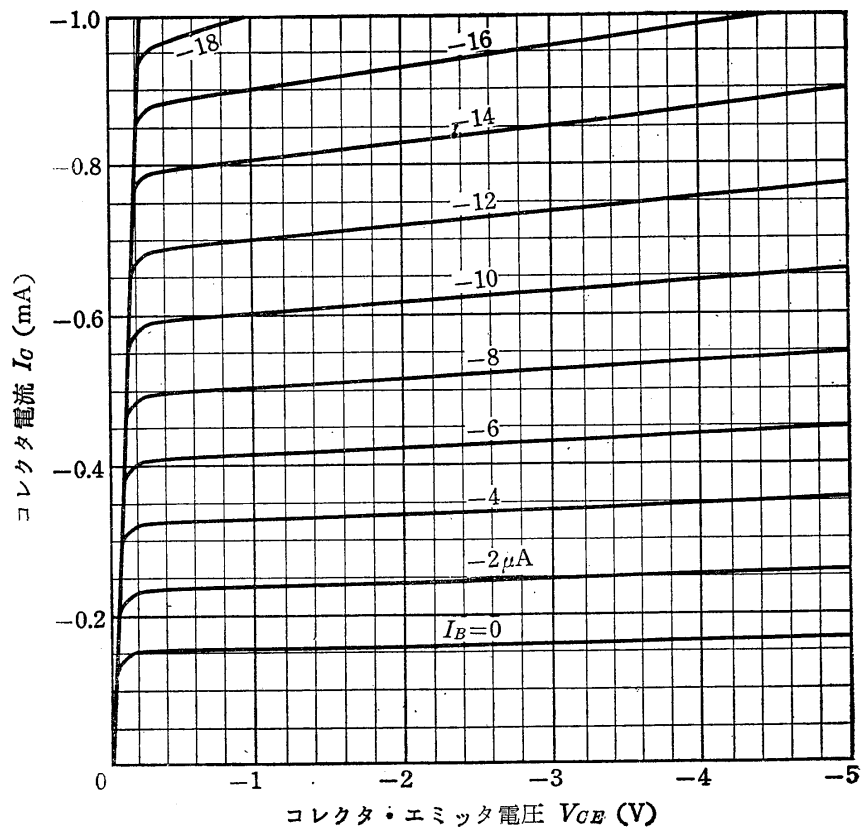
エミッタ接地出力静特性(1)



エミッタ接地出力静特性 (2)

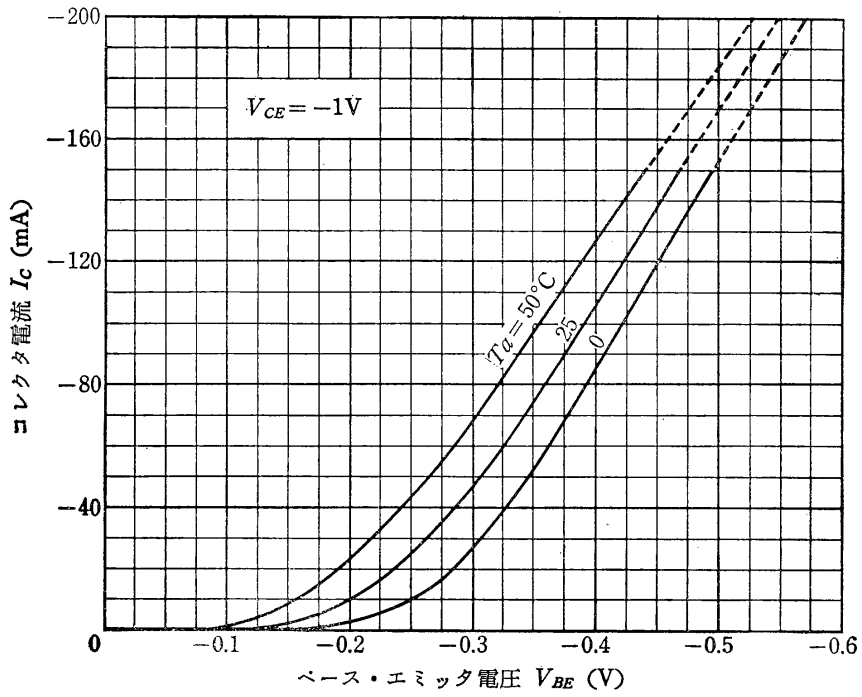


エミッタ接地出力静特性 (3)

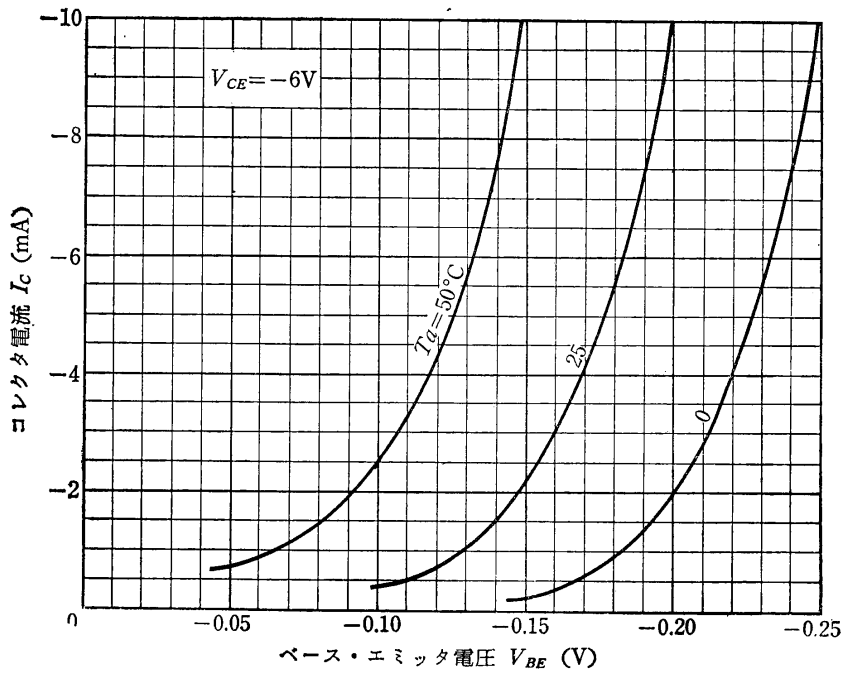


2SB75, 2SB75A, 2SB76

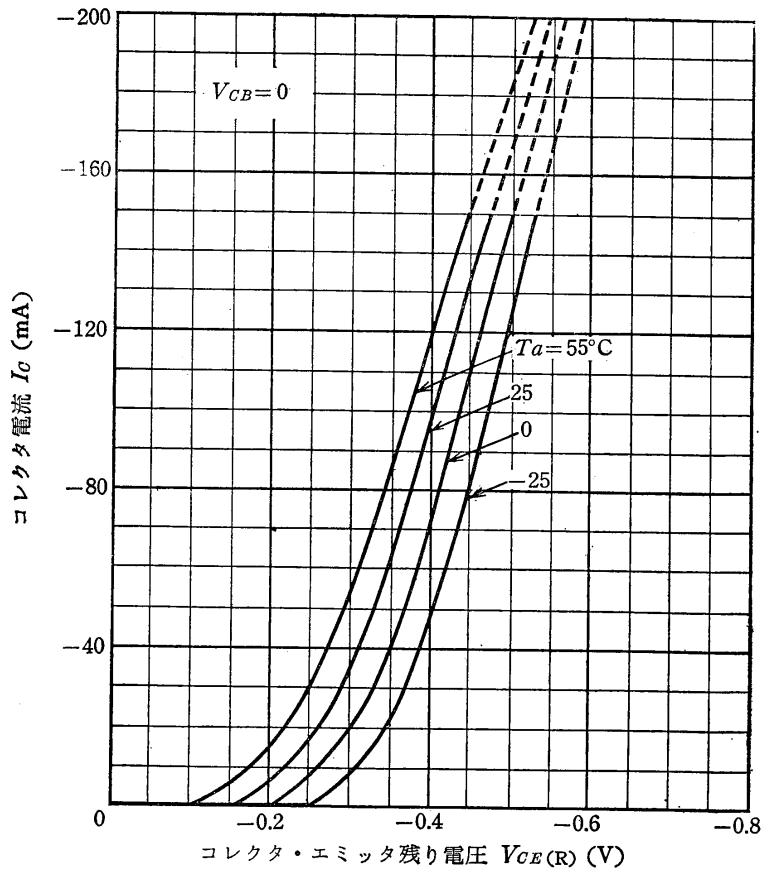
エミッタ接地伝達静特性(1)



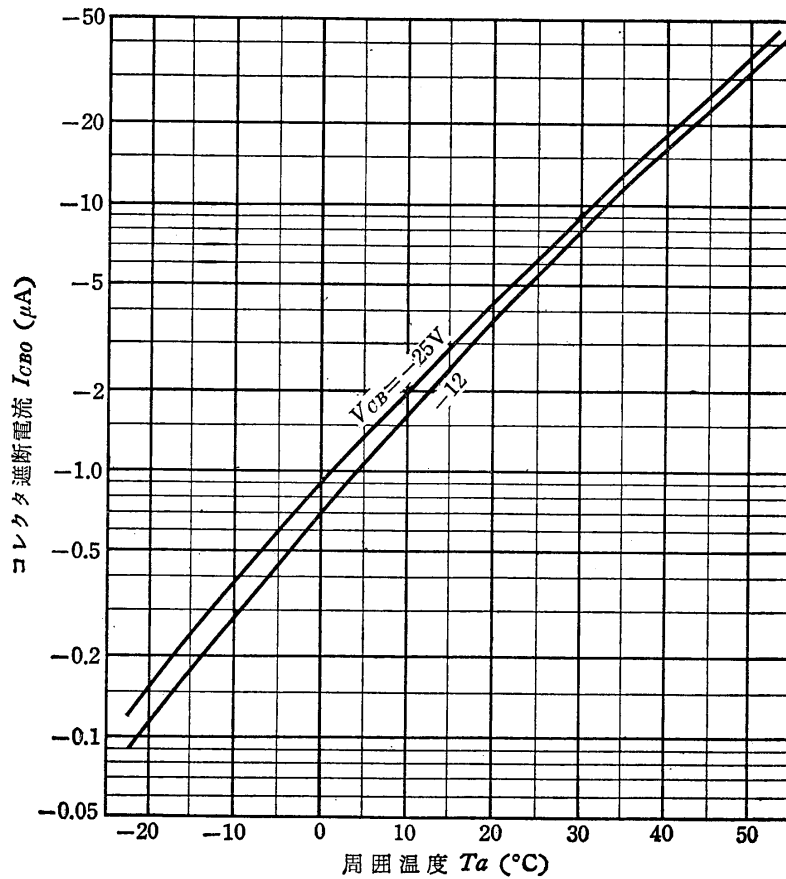
エミッタ接地伝達静特性(2)



コレクタ電流対コレクタ・エミッタ残り電圧特性

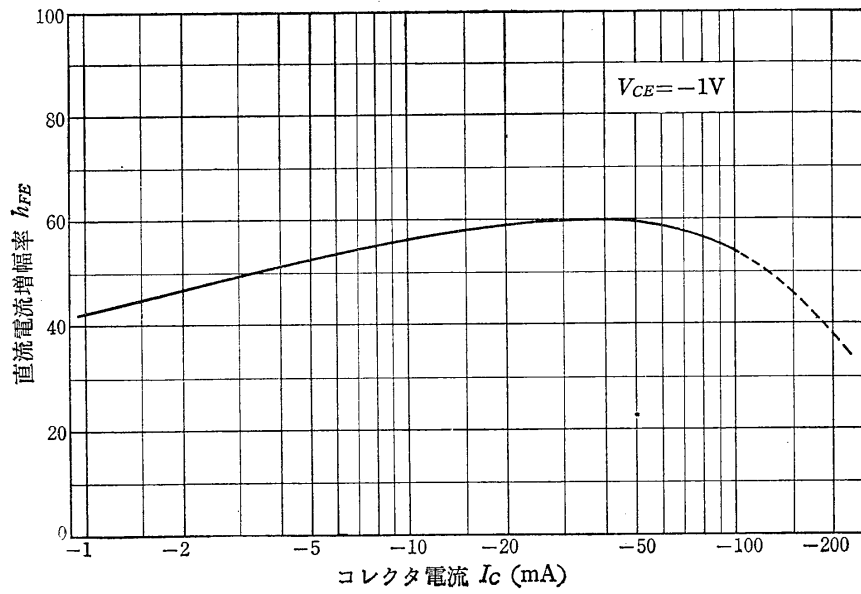


コレクタ遮断電流対周囲温度特性

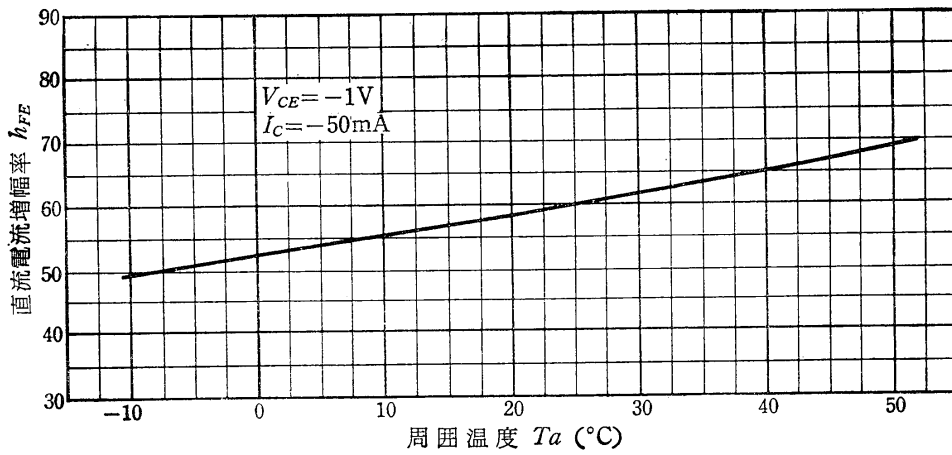


2SB75, 2SB75A, 2SB76

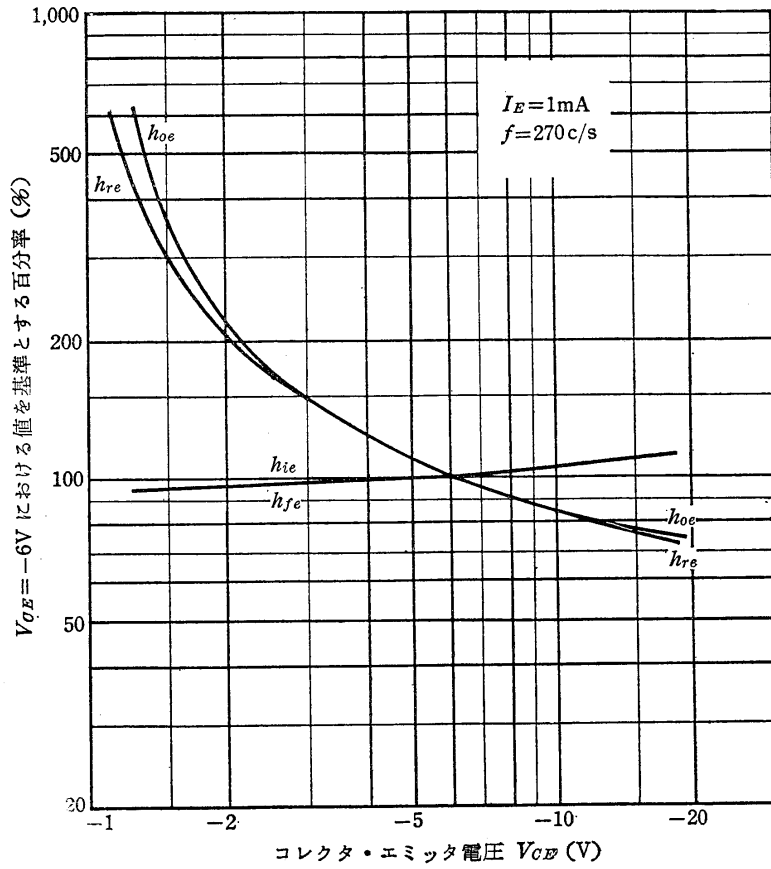
直流電流増幅率対コレクタ電流特性



直流電流増幅率対周囲温度特性



h 定数対コレクタ・エミッタ電圧特性



h 定数対エミッタ電流特性

